

Сведения о ведущей организации
по диссертации Баранова Глеба Владимировича
-«Эффекты пространственного распределения дефектов и примесных атомов в слоистых
структурах на основе Si при ионной имплантации»
по специальности 05.27.01 – твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты,
микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технологический институт имени К.А. Валиева Российской академии наук
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ФТИАН им. К.А. Валиева РАН
Почтовый индекс, адрес организации	117218, Москва, Нахимовский проспект, 34
Веб-сайт	http://ftian.ru/
Телефон	Тел.: (499) 129-50-04 Факс: (499) 125-38-26
Сведения о руководителе, на имя которого нужно оформить письмо	Директор ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, д. ф.-м. н., член-корр. РАН Лукичев В.Ф.
Адрес электронной почты	director@ftian.ru
Сведения о сотруднике, составившем отзыв	Старший научный сотрудник лаборатории МССП, к.ф.-м.н. Мяконьких А.В. (499) 129-55-08 8(926)377-66-61, miakonkikh@ftian.ru
Наименование структурного подразделения, составляющего отзыв	Лаборатория микроструктурирования и субмикронных приборов (МССП)
Список основных публикаций работников структурного подразделения, составляющего отзыв, за последние пять лет по теме диссертации:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Askar Rezvanov, Andrey V. Miakonkikh, Alexey S. Vishnevskiy, Konstantin V. Rudenko, Mikhail R. Baklanov //Cryogenic etching of porous low-k dielectrics in CF₃Br and CF₄ plasmas / Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena. 2017. Т.35, В.2. 021204 (2017); 2. The processes of atomic layer deposition for formation of layers of gate stack HkMG with minimal topology size of 32 nm / K.V. Rudenko, A.V. Miakonkih, A.E. Rogojin, O.P.Guschin, V.A. Gvozdev // Russian Microelectronics. Т.46. №6. (2017). 3. Electromagnetic modeling, technology, and fabrication of microwawe C³MOSHFET switches based on AlGaN/GaN geterostructures / Adonin A.S., Evgrafov A.Yu., Minnebaev V.M., Ivaschenko N.G., Miakonkikh A.V., Rogozhin A.E. Rudenko K.V. // Russian Microelectronics. Т.46. № 6, (2017). " 4. Perspective Method of Betavoltaic Converter Creation / K.V. Rudenko, A.V.Miakonkih, A.E. Rogojin, S.V. Bogdanov, E.T. Lelekov, V.G.Sidorov, P.V.Zelenkov // Perspective Method of Betavoltaic Converter Creation // Journal of Nano- and electronic Physics, - Vol. 8 № 2, 02022 (4 pp) (2016) -- DOI: 10.21272/jnep.8(2).02022. 5. Лукичев В.Ф., Шиколенко Ю.Л. // Современная элементная база запоминающих устройств / Нано- и микросистемная техника. 2015. № 11 (184). С. 40-53 6. Bogoyavlenskaya, E.A., Rudakov, V.I., Denisenko, Y.I., Naumov V. V., Rogozhin A. E., Tech. Phys. (2014) 59: 711. 7. Biosensor Properties of SOI Nanowire Transistors with a PEALD Al₂O₃ Dielectric Protective Layer / V. P. Popova, M. A. Ilnitskii, E. D. Zhanaev, A. V. Myakon'kich, K. 	

- V. Rudenko, and A. V. Glukhov //Semiconductors, 2016, Vol. 50, No. 5, pp. 632–638.
8. STUDY OF THE AMORPHIZATION OF SURFACE SILICON LAYERS IMPLANTED BY LOW-ENERGY HELIUM IONS / Lomov A.A., Myakon'kikh A.V., Oreshko A.P., Shemukhin A.A. // Crystallography Reports. 2016. T. 61. № 2. С. 173-180.
 9. A. Zotovich, A. Rezvanov, R. Chanson, L. Zhang, N. Hacker, K. Kurchikov, S. Klimin, S.M. Zyryanov, D. Lopaev, E. Gornevd, I. Clemente, A. Miakonkikh, K. Maslakov, 2018. "Low-k Protection from F Radicals and VUV Photons using a Multilayer Pore Grafting Approach." Journal of Physics D: Applied Physics 51 (32).
 10. Carbon and fluorine co-implantation for boron diffusion suppression in extremely ultra shallow junctions / Andrey V. Miakonkikh ; Aleksander E. Rogozhin ; Valeriy I. Rudakov ; Konstantin V. Rudenko and Vladimir F. Lukichev // Proc. SPIE 9440, International Conference on Micro- and Nano-Electronics 2014, 94400L (December 18, 2014)
 11. Monte Carlo simulation of boron doping profile of fin and trench structures by plasma immersion ion implantation / Izat S. Shahsenov ; Andrey V. Miakonkikh and Kostantin V. Rudenko // Proc. SPIE 9440, International Conference on Micro- and Nano-Electronics 2014, 94400Y (December 18, 2014);
 12. Lomov A.A., Shcherbachev K.D., Miakonkikh, A.V., Chesnokov, Y.M., Kiselev, D.A./Structural evolution of thermal annealed Si(0 0 1) surface layers fabricated by plasma immersion He+ implantation // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms Volume 431, 15 September 2018, Pages 38-46
 13. Presnov D.E., Bozhev I.V., Miakonkikh A.V., Simakin S.G., Trifonov A.S., Krupenin, V.A. /Local sensor based on nanowire field effect transistor from inhomogeneously doped silicon on insulator // Journal of Applied Physics Volume 123, Issue 5, 7 February 2018, Article number 054503

Ученый секретарь
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН
к.ф.-м.н. И.А. Хорин

